

## プラナリゼーション CMP とその応用(1)

3月17日 11:00~12:00 I室

I07・I08 (キーノートスピーチ)

SiC の酸化剤援用研磨の技術動向

○佐藤 誠 (ノリタケカンパニーリミテド)

I09

サファイア CMP における研磨装置の挙動解析と研磨レートの関係

畝田道雄・○松永敬弘・高橋佳宏 (金沢工大) ・澁谷和孝・中村由夫・市川大造 (不二越機械工業) ・石川憲一 (金沢工大)

## プラナリゼーション CMP とその応用(2)

3月17日 13:00~14:20 I室

I13

革新的“plasma fusion CMP 装置”の設計・試作 (第 6 報) —基本型装置 (A 型) の平坦化特性についての詳細な検討—

○塩澤昂祐・平岡佑太・佐野泰久 (大阪大) ・土肥俊郎・黒河周平 (九州大) ・會田英雄 (九州大, 並木精密宝石) ・大山幸希 (並木精密宝石) ・宮下忠一・住澤春男 (不二越機械工業) ・山内和人 (大阪大)

I14

革新的“plasma fusion CMP 装置”の設計・試作 (第 7 報) —“plasma fusion CMP 装置”(B 型) による加工メカニズムの検討—

○大山幸希 (九州大, 並木精密宝石) ・土肥俊郎 (九州大) ・佐野泰久 (大阪大) ・黒河周平 (九州大) ・會田英雄 (九州大, 並木精密宝石) ・金 聖祐 (並木精密宝石) ・塩澤昂祐 (大阪大) ・西澤秀明 (並木精密宝石) ・山崎 努 (九州大) ・宮下忠一 (不二越機械工業)

I15

電気化学反応を援用した 4H-SiC 基板に対する触媒表面基準エッチング法の開発

○磯橋 藍・山口 航・杉浦崇仁・稲田辰昭・松山智至・佐野泰久・山内和人 (大阪大)

I16

第一原理計算による触媒表面基準エッチング法の加工メカニズムに対する解析

○木谷直隆・磯橋 藍・BuiVan Pho・杉浦崇仁・稲垣耕司・木崎栄年・佐野泰久・森川良忠・山内和人 (大阪大)

## プラナリゼーション CMP とその応用(3)

3月17日 14:40~15:40 I室

I18

**GaN 基板の平坦化加工技術（第 2 報）—高面品位の研削と CMP—**

○伊東利洋・山本栄一（岡本工作機械製作所） ・金安 充（マイテック）

---

I19

**グリーンデバイス用結晶基板の加工プロセス技術の研究開発（第 7 報）—ダイラタンシー・パッド™を用いた SiC 基板の高速圧加工に関する研究—**

○大坪正徳・瀬下 清・山崎 努・西澤秀明・村上 幸（九州大） ・宮下忠一（不二越機械工業） ・高木正孝（フジボウ愛媛） ・土肥俊郎（九州大）

---

I20

**グリーンデバイス用結晶基板の加工プロセス技術の研究開発（第 8 報）—特殊形状砥粒による SiC 基板の加工に関する考察—**

○西澤秀明・瀬下 清・山崎 努・佐々木英二・塚本敬一・村上 幸・光原乃里子（九州大） ・柏田真吾・中山和洋・小柳嗣雄・俵迫祐二（日揮触媒化成） ・土肥俊郎（九州大）

---

**プラナリゼーション CMP とその応用(4)**

3月17日 16:00~17:00 I室

I22

**ファイバードレッサによるパッドドレッシングの有効性評価とそのメカニズム—ファイバー挙動の高速その場観察—**

畝田道雄・○高橋直紀（金沢工大） ・新井雄太郎（昭和工業） ・藤田 隆（東京精密）

---

I23

**研磨パッドの表面突起構造の分析とカ学モデルの検討**

○橋本洋平・大鹿真悟・鈴木教和・社本英二（名古屋大）

---

I24

**フェムト秒レーザーを用いた半導体ウェハ表面のコヒーレントフォノン励起加工に関する研究**

○林 照剛・横尾英昭・王 成武・松川洋二・黒河周平（九州大）